

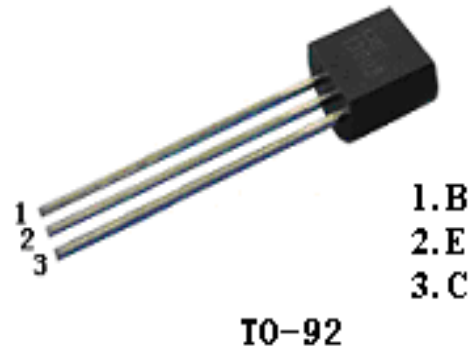
● 硅 NPN 外延平面管

● 用途:

高频放大/振荡/混频

● 特点:

- 高传输频率 f_T ;
- 低输出电容 C_{ob} 、 C_{rb} 。



Package : TO-92

Marking Symbol: C3355 K26

● 极限参数($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	单位	规范值
耗散功率	P_{tot}	mW	200
集电极电流	I_c	mA	100
结温	$T(j)$	$^\circ\text{C}$	125
贮存温度	T_{stg}	$^\circ\text{C}$	-55~+125
集电极-基极电压	V_{CB0}	V	20
集电极-发射极电压	V_{CEO}	V	12
发射极-基极电压	V_{EBO}	V	3

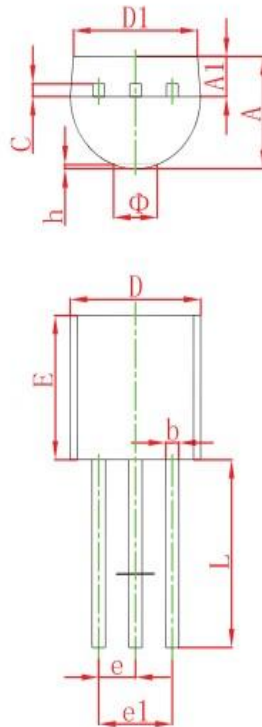
● 电参数($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	测试条件	最小值	最大值	单位
V_{CB0}	$I_C = 10\mu\text{A}$ $I_E = 0$	20		
V_{CEO}	$I_C = 1\text{mA}$ $I_B = 0$	12		
V_{EBO}	$I_E = 10\mu\text{A}$ $I_C = 0$	3		
I_{CB0}	$V_{CB} = 10\text{V}$ $I_E = 0$		1.0	μA
I_{CEO}	$V_{CE} = 12\text{V}$ $I_B = 0$		1.0	μA
I_{EBO}	$V_{EB} = 1\text{V}$ $I_C = 0$		90	nA
H_{FE}	$V_{CE} = 10\text{V}$ $I_C = 20\text{mA}$	60	260	
f_T	$V_{CE} = 10\text{V}$ $I_C = 20\text{mA}$	TYP: 7.0		GHz
C_{re}	$V_{CB} = 10\text{V}$ $I_E = 0$ $f = 1\text{MHz}$		1.0	pF
NF	$V_{CE} = 10\text{V}$ $I_C = 7\text{mA}$ $f = 1.0\text{GHz}$		2.0	dB

● H_{FE} 分档

Rank	A	B	C
H _{FE}	60-120	100-200	180-260

● DIMENTION 封装外形尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.300	3.700	0.130	0.146
A1	1.100	1.400	0.043	0.055
b	0.380	0.550	0.015	0.022
c	0.360	0.510	0.014	0.020
D	4.300	4.700	0.169	0.185
D1	3.430		0.135	
E	4.300	4.700	0.169	0.185
e	1.270 TYP		0.050 TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	14.100	14.500	0.555	0.571
Φ		1.600		0.063
h	0.000	0.380	0.000	0.015